

「省エネエレクトロニクスの製造基盤強化に向けた技術開発事業基本計画（案）」に対するパブリックコメント募集の結果について

2021年3月5日
NEDO
IoT推進部

NEDO POSTにおいて標記基本計画（案）に対するパブリックコメントの募集を行いました結果をご報告いたします。
貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

1. パブリックコメント募集期間

2021年1月25日～2021年2月8日

2. パブリックコメント投稿数<有効のもの>

計3件

3. パブリックコメントの内容とそれに対する考え方

ご意見の概要	ご意見に対する考え方	基本計画・技術開発課題への反映
全体について（2件）		
<p>[意見1] 酸化ガリウムの幅広い結晶構造の薄膜形成や薄膜製造装置、微細加工技術について、我が国特有の先導研究を積極的に実施すべきと考える。</p> <p>[意見2] 酸化ガリウムのMOSFETを実現できるp型化技術やp型を必要としない高周波用途のHEMTの先導研究を積極的に実施すべきと考える。</p>	<p>[考え方と対応] 酸化ガリウムの先導研究については、いただきましたご意見も参考にして、今後、状況に即して検討して参ります。</p>	<p>[反映の有無と反映内容] 特になし</p>
(3) 研究開発の内容（1件）		
<p>[意見1] Siインテリジェントパワー半導体の後継となる、、SiCのインテリジェントパワー半導体の研究テーマを提案する。</p>	<p>[考え方と対応] SiCのインテリジェントパワー半導体の研究については、いただきましたご意見も参考にして、今後、状況に即して検討して参ります。</p>	<p>[反映の有無と反映内容] 特になし</p>

以上